

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника, кандидата наук
в лаборатории оптики кристаллов и гетероструктур с экстремальной двумерностью
Вакансия VAC_61301

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физики и технологии многофункциональной полупроводниковой фотоники на основе (Al,Ga)N гетероструктур, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии

Трудовая деятельность

Участие в научных исследованиях по разработке полупроводниковых фотоприемных и светоизлучающих структур в составе коллектива лаборатории, включая:

- разработка технологических процессов эпитаксиального роста (Al,Ga)N гетероструктур с использованием плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии;
- исследования структурных свойств гетероструктур с использованием растрового и просвечивающего электронных микроскопов, а также атомарно-силовой микроскопии и метода рентгенодифракционного анализа;
- руководство и обучение студентов, лаборантов и стажеров-исследователей фундаментальным и прикладным навыкам разработки и исследования гетероструктур и лазерных диодов на их основе.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

Особенности трудовой деятельности: работа на период выполнения проекта Российского Научного Фонда. Оклад на бюджетной ставке 21 414 руб., надбавки - ежемесячно по результатам работы и в зависимости от квалификации соискателя (количество научных статей в рецензируемых изданиях за последние 2 года).

При оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих критериев:

- Наличие ученой степени кандидата физико-математических, технических, или химических наук (требование Российского Научного Фонда).
- Возраст не старше 35 лет (требование Российского Научного Фонда).
- Будущий сотрудник не должен являться сотрудником ФТИ им. А.Ф. Иоффе на период 2018-2019 гг. (требование Российского Научного Фонда).
- Владение английским языком.
- Опыт работы в области физики и технологии полупроводниковых гетероструктур АЗВ5 и полупроводниковых приборов на их основе будет преимуществом.
- Наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Web of Science Core Collection и/или Scopus.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместитель директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе П.Н. Брункову, телефон для справок: (812)2927196. Электр. почта : brunkovpn@mail.ioffe.ru